

数学与系统科学研究院

计算数学所学术报告

报告人： 吴振华 博士

(中国科学院微电子研究所)

报告题目：

先进工艺下器件仿真工具介绍

邀请人： 崔涛 副研究员

报告时间： 2020 年 12 月 1 日 (周二)

上午 9:30-11:00

报告地点： 数学院南楼

204 教室

摘要:

本报告将主要介绍现有的先进工艺节点下器件仿真工具所采用的核心数学模型、方法和工具的使用。还将介绍当前工具在数学模型和方法上面面临的挑战。

个人简介:

2006 年于南京大学物理学系微电子专业获学士学位，2011 年于中国科学院半导体研究所获理学博士学位。2011 年-2016 年于三星电子韩国总部半导体研发中心任半导体器件高级研发工程师。参与研发世界领先的 14nm,10nm 节点半导体逻辑芯片，主要从事三维鳍形晶体管 FinFET 中的载流子输运特性研究，TCAD 仿真，性能表征，优化，可靠性分析。2016 年入选中国科学院率先行动百人计划“青年俊才”项目，进入中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心任研究员至今。已在国际一流学术杂志 (JAP,APL,Nanotechnology,RCSAdv.,PCCP,PRB,PRL,NatureMaterials 等)发表同行评议学术论文 30 余篇，被引用次数近 900 次，两篇论文入选 ESI 高引论文。APL, PRB 等期刊以及 IEEEISPAD,IEEEISCAS 等会议审稿人。目前研究兴趣包括 FinFET,亚 10 纳米 CMOS 架构与关键技术，低维介观系统中电荷/自旋量子输运特性，机器学习在半导体器件 TCAD 仿真中的应用，半导体量子比特等

欢迎大家参加!